PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

58-026394

(43)Date of publication of application: 16.02.1983

(51)Int.Cl.

G11C 11/34 G06F 3/00

G06F 9/46 G06F 13/00

(21)Application number: 56-123423

(71)Applicant: FUJITSU LTD

(22)Date of filing:

06.08.1981

(72)Inventor: MATSUBARA SATOSHI

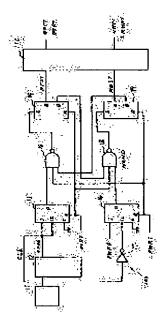
HAMADA TAKASHI

(54) COMPETITION CIRCUIT

(57)Abstract:

PURPOSE: To efficiently process refresh operation which is finished in a shorter cycle time than R/W operation, by independently providing a reset signal from an access request signal and a refresh request signal to memories.

CONSTITUTION: When refresh is requested with a refresh request (RFR) Q signal at "1", a Q output of an FF113 goes to "1" at the tail ridge of an output CLK of an OSC11. The level of RWRT and Q' output of an FF4 is both at "1" and an FF214 is set, and the level of REST25 is at "1" and refresh is executed. If R/W request is available during this period, registration is made to an FF316 at the front ridge of the CLK, the Q' output of the FF2 goes to "0" during the execution of refresh, a NAND gate G218 is not set and the RWST 210 remains "0". An RFRT26 goes to "0" at the end of the refresh and the Q' output of the FF2 goes to "1". When the RFRT26 changes from "0" to "1", the 218 is set and an FF419 is set.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

(9) 日本国特許庁 (JP)

①特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭58—26394

	識別記号 101	庁内整理番号 7922-5B	❸公開 昭和58年(1983)2月16	B
G 06 F 3/00 9/46	1 0 1	7165—5B 6745—5B	発明の数 1 審査請求 有	
13/00	1 0 1	7056—5B	(全 4 頁	O

9競合回路

②特

願 昭56—123423

愛出 願 昭56(1981)8月6日

⑫発 明 者 松原敏

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑫発 明 者 浜田隆史

川崎市中原区上小田中1015番地

富士通株式会社内

⑪出 願 人 富士通株式会社

川崎市中原区上小田中1015番地

ゆ 代 理 人 弁理士 松岡宏四郎

明 細 電

発明の名称
 競合回路

2. 特許請求の範囲

互いに非同期に発生する2つの要求信号(例えばメモリへのアクセス要求信号とリフレッシュ要求信号)が同時期に発生した場合の競合を側御するための回路において、上配2つの要求信号をクロック信号のそれぞれ削離、後級で登録するFF(フリップフロップ)と、2つの要求信号に対応した2つの独立したリセットタイミング信号を有し、該リセットタイミング信号を用いて前配2つの要求信号を制御する手段を設けたことを特徴とする競合回路。

3. 発明の詳細な説明

本発明は信号の競合を制御する回路に係り、特に に に非開期性発生する2つの要求信号の競合回路に 関する。

従来、との権の回路においては、外部からのア クセス投水は、メモリが智度込み取いは銃み出し

この目的は互いに非同期に発生する2つの要求 (はち) (例えがメモリへのアクセス要求信号とリフレッシュ 要求信号) が同時期に発生した場合の 飲合を制御するための 回路にかいて、上配 2 つの 要求信号をクロック 信号のそれぞれ 前継, 後 散で 登録する FF(フリップフロップ)と、2つの要求 信号に対応した2つの独立したリセットタイミング信号を有し、該リセットタイミング信号を有し、該リセットタイミング信号を有し、該リセットタイミング信号を有し、該リセットタイミング信号を有し、該リセットタイミング信号を用い

て前記2つの要求信号を制御する手段を設けたと とを特徴とする競合回路により達成される。

以下図面を使って本発明を詳細に説明する。

第1図は本発明の一実施例を示す競合回路図で ある。

図において、11はOSC(オシレーター)、12 はCOUNT(カウンタ)、13はFF1(フリッ プフロップ1)、14はFF2(フリップフロッ プ2)、15はG1(ゲート1)、16はFF3(フリップフロップ3)、17はG3(ゲート3)、 18はG2(ゲート2)、19はFF4(フリッ プフロップ4)、110はタイミング作成回路である。

第2図は本発明の一実施例を示すタイムチャー トである。

図において、21はOSC出力(CLK信号)、
22はCOUNT出力(RFRQ信号)、23は
FF1のQ出力、24はFF2のS入力、25は
RFST、26は※RFRT、27はRWRQ、28
はFF3のQ出力、29はFF4のS入力、210

- 3 -

であるため、NANDゲートG 2 1 8 が開かす RWS T 2 1 0 は"L" のままである。

そしてリフレッシュ動作が終了した時点で*KFRT 26が"L"とカリFF2のQ出力が"H"となる。 さらに*RFRT26が"L"→"H"と変化した時点 でG218が開き、FF419がセットされる。 とりしてリフレッシュ動作が終るやいなやR/W 動作が実行される。

ことでリセットタイミング*RFRT26 信号は リフレッシュ動作を終了するタイミングであると 共に、RFST25 が"L"となってから、RWST 210 を"H"とするまでの間のOFF時間を制御 するための重要な信号である。

同様の動作が、R/W要求が先に受け付けられ、 「 その後リフレッシュ要求が出た場合にも行われる。

本回路に於いては、リセット信号を耐要求信号 について独立に持ったため、R/W動作に比して 短かいサイクルタイムで終了するリフレッシュ動 作を効率良く処理することができる。

又、要求借号は1 CLKサイクル以上"H" であ

特問報58-26394(2)

はRWST 、211は*RWRT、213はリフレッシュのスタート信号、215はメモリのR/Wスタートである。

さて、メモリシステムにおける外部からのR/W 要求と内部で発生するリフレッシュ要求の競合を 例として眼明しよう。

FF113が COUNT12により発生したリフレッシュ要求 (RFRQ) を登録するためのFFであり、FF316がR/W動作の要求信号 (RWRQ27)を登録するためのFFでリップフロップ回路以下FFと書くである。

今、RFRQ信号が"H"レベル(値1)となり、 リフレッシュ製水がされた場合、FF113のQ出 力がOSC11の出力CLKの後縁で"H"レベル となる。この時、*RWRT、FF4Q出力は共化 "H"であり、FF214はセットされ、RFST25 が"H"となり(213)リフレッシュが実行される。

もし、との間にR/W要求があれば(RWRQ27 ="H")FF316へはCLKの削級で登録される が、リフレッシュ実行中はFF2のQ出力が"L"

- 4 -

れば確実にFF13, FF3(16)にセットされるので、要求信号を、動作開始まで保持するための側御が不要である。

一般に、メモリ紫子においては、アクセスされてから、次のアクセスを受けるまでに一定の休止期間が必要であるが、本回路を用いれば、RFST25及びRWST210間のOFF期間をそれぞれ*RFRT26,*RWRTの幅を変えることにより、自由に制御できるので、FF214,FF419の出力を単にORすることにより直接メモリ紫子へのスタート信号として使用出来、メモリへの早いアクセスが可能である。

なおCLK信号の"H"期間; TH; "L"期間; Tひは下記の値を満足すれば良い。

TH > Tdg, + Tdf, + Tdg, + Tdf, - Tdf,

TL> Tdf, + Tdg, + Tdf, - Tdg, - Tdf,

2 C τ,

Tolg,: NAND G1の素子遅延

Tdg,; " G2 "

Tdg. ; NNV G3 "

--614---

特別で358- 2639**4(3)**

Tdf, : FF1の 紫子遊延

Tdf, ; FF2

Tdf. : FF3 "

Tdf, ; FF4 "

である。

以上では、外部からのR/W映水と、内部で発生するリフレッシュ映水の競合の一例であったが、変形例として、同一のメモリシステムに対して2つのCPUからのアクセス映水がある場合、又は同一メモリシステムに対してCPUとI/Oからの映水がある場合等が考えられる。

以上脱即したよりに本務明によれば次の3つの 効果がある。

- ① 要求信号は1クロック周期を超える幅であれば良く、実際の動作に入るまで要求信号を保持しておく必要がない。
- ② FFのリセット信号を適当にタイミング設定 することにより耐要求信号に対して独立に自由 にサイクルタイムを設定でき効率の良い処理が 可能である。

-7-

はタイミング作成回路、21はOSC出力(CL K信号)、22はCOUNT出力(RFRQ信号)、 23はFF1のQ出力、24はFF2のS入力、 25はRFST、26は※RFRT、27はRWRQ 28はFF3のQ出力、29はFF4のS入力、 210はRWST、211は*RWRT、213はリフ レッシュのスタート信号、215はメモリのR/W スタート。

代理人 弁理士 松岡 宏四郎

1756間30-26334(3)さらに前製水信号の間の休止期間を自由に制御できるため、最終段下下の出力を直接タイミング信号として使用でき、特にメモリシステムにおいては有効である。

- ③ 従来の競合回路で用いられていた、NOR回 防、オープンコレクタゲート、シュミットトリ ガゲート、終端抵抗等が不要となり、FF。 NAND、INVの3種の部品で構成されており、 部品数の削減、低価格化の効果がある。
- 4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明の一裏施例を示す競合回路図である。無2図は本発明の一裏施例を示すタイムチャートである。

配号の説明、11はOSC(オシレータ)、12 はCOUNT(カウンタ)、13はFF1(フリップフロップ1)、14はFF2(フリップフロップ2)、15はG1(NANDゲート1)、16は FF3(フリップフロップ3)、17はG3(インパータゲート3)、18はG2(NANDゲート 2 入19はFF4(フリップフロップ4)、110

- 8 -

